

半 导 体 学 报

第 10 卷 第 10 期 1989 年 10 月

目 录

- 两性杂质锗在 LPE GaAs 中分凝系数和占位比的计算……杨 辉 梁骏吾 (725)
- 具有 $1/ch^2$ 界面的介质光波导的模方程……马春生 刘式墉 (733)
- $Ga_{0.47}In_{0.53}As/SiO_2$ 与 $Ga_{0.47}In_{0.53}As/Al_2O_3$ 的界面性质……
……江若璠 郑有焯 傅 浩 邵建军 黄善祥 (739)
- 半导体激光器的动态模式增益谱……谢京涛 张存善 郑云龙 李佩璠 (746)
- 轻掺杂漏 (LDD) MOSFET 的数值模拟……郑庆平 章倩苓 阮 刚 (754)
- 晶体硅中氢钝化硼的机理……施天生 钟 钦 (763)
- 氢气放电无窗输出型光 CVD 非晶、微晶硅薄膜……
……郭述文 朱基千 谭沁生 王渭源 (769)
- 大功率晶体管刻槽与钝化工艺研究……万积庆 廖晓华 (775)

研究简报

- $TiSi_2$ 薄膜的形成特性及 $TiSi_2$ /多晶硅复合栅结构的研究……
……陶 江 赵铁民 张国炳 王阳元 汪锁发 李永洪 (781)
- GaAs/AlGaAs 多量子阱激光器……张永航 孔梅影 陈良惠 王启明 (788)

研究快报

- $1.5\mu m$ InGaAsP/InP 脊型波导分布反馈激光器……王 圩 张静媛
田慧良 缪育博 汪孝杰 马朝华 王丽明 吕 卉 高俊华 高洪海 (794)
- 一种 GaAs/GaAlAs 分别限制单量子阱锁相阵列激光器……
朱龙德 G. A. B. Feak J. M. Ballantyne D. K. Wagner P. L. Tihanyi (799)